

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number : 11-211651

(43)Date of publication of application : 06.08.1999

(51)Int.Cl.

G01N 15/14
G01N 15/02

(21)Application number : 10-015408

(71)Applicant : RION CO LTD

(22)Date of filing : 28.01.1998

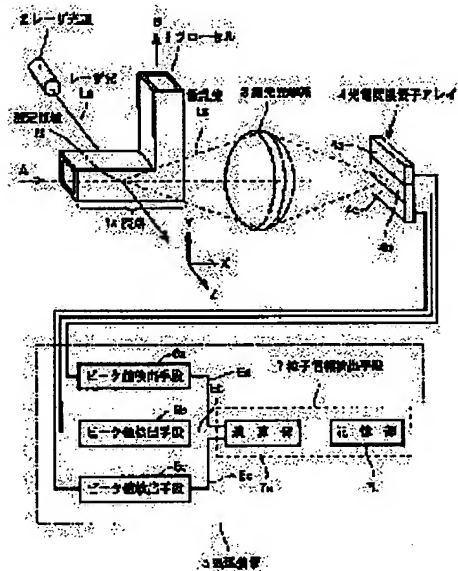
(72)Inventor : MATSUDA TOMONOBU

(54) LIGHT INTENSITY DISTRIBUTION DETECTION DEVICE

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To obtain the intensity distribution of laser beams at a measurement region where particles pass.

SOLUTION: A detection device is provided with a flow cell 1 that is formed by a transparent member so that it is flexed, a laser light source 2 for forming a measurement region M by applying laser beams La to a channel 1a of the flow cell 1, a condensation optical system 3 that has a light axis being matched to the center axis of the channel 1a and condenses scattered light Ls of a particle being generated by the measurement region M, a light detection means 4 consisting of three optoelectric conversion elements 4a, 4b, and 4c for receiving the scattered light Ls being condensed by the condensation optical system 3, peak value detection means 6a, 6b, and 6c for detecting peak values of the output voltage of the three optoelectric conversion elements 4a, 4b, and 4c, and a position detection means 7 for comparing the output signals of the peak value detection means and outputting the passage position information of the measurement region M where the particle passed and the scattered light intensity data of particles.



LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

31.05.2001

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

3480670

[Date of registration]

10.10.2003

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

BEST AVAILABLE COPY

[Date of requesting appeal against examiner's
decision of re[redacted]n]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

特開平 1 1 - 2 1 1 6 5 1

(43) 公開日 平成 1 1 年 (1 9 9 9) 8 月 6 日

(51) Int. Cl.

G01N 15/14

15/02

識別記号

F I

G01N 15/14

15/02

P

A

審査請求 未請求 請求項の数 5 O L (全 1 5 頁)

(21) 出願番号 特願平 1 0 - 1 5 4 0 8

(22) 出願日 平成 1 0 年 (1 9 9 8) 1 月 2 8 日

(71) 出願人 0 0 0 1 1 5 6 3 6

リオン株式会社

東京都国分寺市東元町 3 丁目 2 0 番 4 1 号

(72) 発明者 松田 朋信

東京都国分寺市東元町 3 丁目 2 0 番 4 1 号

リオン株式会社内

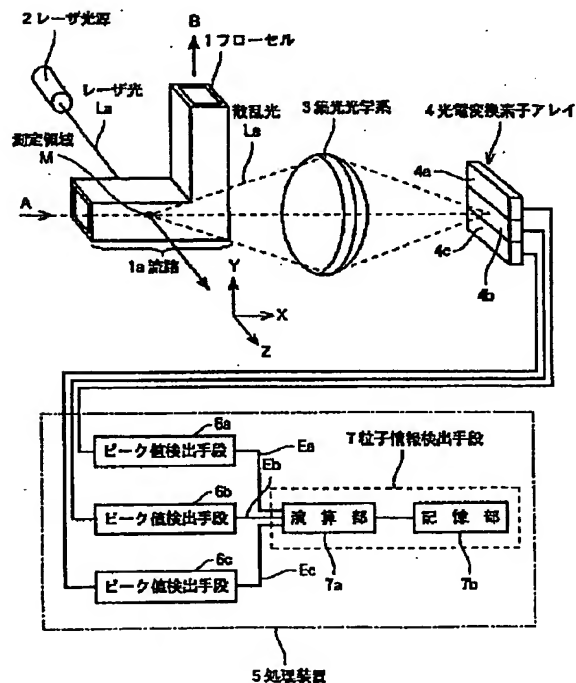
(74) 代理人 弁理士 小山 有 (外 1 名)

(54) 【発明の名称】 光強度分布検出装置

(57) 【要約】

【課題】 粒子が通過する測定領域のレーザ光の強度分布を求める。

【解決手段】 透明部材で屈曲形状に形成したフローセル 1 と、このフローセル 1 の流路 1 a にレーザ光 L a を照射して測定領域 M を形成するレーザ光源 2 と、流路 1 a の中心軸と一致する光軸を有して測定領域 M で発生する粒子の散乱光 L s を集光する集光手段 3 と、この集光手段 3 が集光した散乱光 L s を受光する 3 個の光電変換素子 4 a、4 b、4 c から成る光検出手段 4 と、3 個の光電変換素子 4 a、4 b、4 c の出力信号のピーク値を検出するピーク値検出手段 6 a、6 b、6 c と、このピーク値検出手段 6 a、6 b、6 c の出力信号を互いに比較して粒子が通過した測定領域 M の通過位置データと粒子の散乱光強度データを出力する粒子情報検出手段 7 を備える。



【特許請求の範囲】

【請求項 1】 透明部材で屈曲形状に形成したフローセルと、このフローセルの流路に光を照射して測定領域を形成する光源と、前記流路の中心軸と一致する光軸を有して前記測定領域で発生する粒子の散乱光を集光する集光手段と、この集光手段が集光した散乱光を受光する複数の光電変換素子から成る光検出手段と、前記複数の光電変換素子の出力信号を検出する電圧検出手段と、この電圧検出手段の出力信号を互いに比較して粒子が通過した前記測定領域の通過位置データと粒子の散乱光強度データを出力する粒子情報検出手段を備えることを特徴とする光強度分布検出装置。

【請求項 2】 前記複数の光電変換素子から成る光検出手段は、各受光面が前記流路の中心軸に垂直で、且つ前記流路の中心軸と前記光源の光軸にほぼ垂直な方向に隣接して設けた N (N は 2 以上の整数) 個の光電変換素子から成る光電変換素子アレイである請求項 1 記載の光強度分布検出装置。

【請求項 3】 前記複数の光電変換素子から成る光検出手段は、縦と横が V 個 \times H 個 (V 、 H とも 2 以上の整数) の光電変換素子から成り、各受光面が前記流路の中心軸に垂直である請求項 1 記載の光強度分布検出装置。

【請求項 4】 透明部材で形成したフローセルと、このフローセルの流路に光を照射して測定領域を形成する光源と、前記光の中心軸と一致する光軸を有して前記測定領域で発生する粒子の散乱光を集光する集光手段と、この集光手段の光軸上に位置するトラップと、前記集光手段が集光した散乱光を受光する複数の光電変換素子から成る光検出手段と、前記複数の光電変換素子の出力信号を検出する電圧検出手段と、この電圧検出手段の出力信号を互いに比較して粒子が通過した前記測定領域の通過位置データと粒子の散乱光強度データを出力する粒子情報検出手段を備えることを特徴とする光強度分布検出装置。

【請求項 5】 前記複数の光電変換素子から成る光検出手段は、各受光面が前記光源の光軸に垂直で、且つ前記流路の中心軸と前記光源の光軸にほぼ垂直な方向に隣接して設けた N (N は 2 以上の整数) 個の光電変換素子で成る光電変換素子アレイである請求項 4 記載の光強度分布検出装置。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【発明の属する技術分野】 本発明は、測定領域に照射した光の強度分布を検出する装置で、例えば流路を通過する粒子の個数を粒径を弁別してカウントする粒子計数装置に適用する光強度分布検出装置に関する。

【0002】

【従来の技術】 従来の粒子計数装置としては、図 18 に示すように、レーザー光 L_a をフローセル 100 の内部流路に照射し、この内部流路を粒子が通過する際に、粒子

が放出する散乱光 L_s を集光光学系 101 によって光電変換素子 102 に集光させ、光電変換素子 102 の出力信号に基づき、比較回路 103 及びパルス計数回路 104 により、内部流路を通過する粒子の個数を粒径を弁別して計数する光散乱式粒子計数装置が知られている。

【0003】 光電変換素子 102 は、粒子が内部流路を通過すると、粒子が放出する散乱光 L_s に応じたパルス状の電圧を出力する。このパルス状の電圧の波高値は、粒子の粒径によって変化する。比較回路 103 は、光電変換素子 102 の出力電圧を所定値と比較し、光電変換素子 102 の出力電圧が所定値より大きいとき、所定の粒径よりも大きいとしてパルス信号を出力する。このパルス信号をパルス計数回路 104 により計数して、粒子の個数を検出する。

【0004】

【発明が解決しようとする課題】 しかし、図 18 に示す光散乱式粒子計数装置においては、レーザー光 L_a を照射した内部流路のレーザー光強度が一定でない場合、粒径の弁別を誤って計数するという問題がある。内部流路のレーザー光強度は、一般にレーザー光束の中心部が最も高く、中心部からずれて端部に行くほど低くなるという分布（ほぼガウス分布）を示す場合が多い。

【0005】 従って、粒子の粒径及び光学的性質は同じであっても、レーザー光束の端部を通過するときと、中心部を通過するときとでは、粒子の散乱光 L_s の強度が異なり、光電変換素子 102 の出力電圧が異なる。そのため、比較回路 103 の出力信号も異なり、パルス計数回路 104 が粒子を計数する場合としない場合がある。

【0006】 本発明は、従来の技術が有するこのような問題点に鑑みてなされたものであり、その目的とするところは、光の強度分布が分かれば、従来の問題点が解決される点に着目して、光を照射した測定領域の光強度分布を求めることができる光強度分布検出装置を提供しようとするものである。

【0007】

【課題を解決するための手段】 上記課題を解決すべく請求項 1 に係る発明は、透明部材で屈曲形状に形成したフローセルと、このフローセルの流路に光を照射して測定領域を形成する光源と、前記流路の中心軸と一致する光軸を有して前記測定領域で発生する粒子の散乱光を集光する集光手段と、この集光手段が集光した散乱光を受光する複数の光電変換素子から成る光検出手段と、前記複数の光電変換素子の出力信号を検出する電圧検出手段と、この電圧検出手段の出力信号を互いに比較して粒子が通過した前記測定領域の通過位置データと粒子の散乱光強度データを出力する粒子情報検出手段を備えるものである。

【0008】 請求項 2 に係る発明は、請求項 1 記載の光強度分布検出装置において、前記複数の光電変換素子から成る光検出手段は、各受光面が前記流路の中心軸に垂

直で、且つ前記流路の中心軸と前記光源の光軸にほぼ垂直な方向に隣接して設けたN（Nは2以上の整数）個の光電変換素子から成る光電変換素子アレイである。

【0009】請求項3に係る発明は、請求項1記載の光強度分布検出装置において、前記複数の光電変換素子から成る光検出手段は、縦と横がV個×H個（V、Hとも2以上の整数）の光電変換素子から成り、各受光面が前記流路の中心軸に垂直である。

【0010】請求項4に係る発明は、透明部材で形成したフローセルと、このフローセルの流路に光を照射して測定領域を形成する光源と、前記光の中心軸と一致する光軸を有して前記測定領域で発生する粒子の散乱光を集光する集光手段と、この集光手段の光軸上に位置するトラップと、前記集光手段が集光した散乱光を受光する複数の光電変換素子から成る光検出手段と、前記複数の光電変換素子の出力信号を検出する電圧検出手段と、この電圧検出手段の出力信号を互いに比較して粒子が通過した前記測定領域の通過位置データと粒子の散乱光強度データを出力する粒子情報検出手段を備えるものである。

【0011】請求項5に係る発明は、請求項4記載の光強度分布検出装置において、前記複数の光電変換素子から成る光検出手段は、各受光面が前記光源の光軸に垂直で、且つ前記流路の中心軸と前記光源の光軸にほぼ垂直な方向に隣接して設けたN（Nは2以上の整数）個の光電変換素子で成る光電変換素子アレイである。

【0012】

【発明の実施の形態】以下に本発明の実施の形態を添付図面に基づいて説明する。ここで、図1は本発明の第1の実施の形態に係る光強度分布検出装置の構成図、図2は図1におけるレーザ光を照射した測定領域の平断面図、図3は図1におけるレーザ光を照射した測定領域の縦断面図、図4乃至図8は図1における光電変換素子アレイの受光状態（a）とそのときの出力波形（b）を示す図、図9は粒子情報参照テーブルを示す図、図10は本発明の第2の実施の形態に係る光強度分布検出装置の構成図、図11は本発明の第3の実施の形態に係る光強度分布検出装置の構成図、図12は図11におけるレーザ光を照射した測定領域の縦断面図、図13乃至図17は図11における光電変換素子アレイの受光状態（a）とそのときの出力波形（b）を示す図である。

【0013】本発明の第1の実施の形態に係る光強度分布検出装置は、図1に示すように、フローセル1、レーザ光源2、集光光学系3、光電変換素子アレイ4及び処理装置5から成る。

【0014】フローセル1は、透明部材から成り、所定長さの直線流路1aを有し、全体として屈曲している。フローセル1は、断面形状を四角形状とし、全体としてL型筒形状に形成したものである。直線流路1aの中心軸は、X方向と一致している。

【0015】所定長さの直線流路1aを設けた理由は、

フローセル1に供試流体を流したとき、供試流体の流れを層流にするためである。なお、層流を得るための条件としては、供試流体の粘度、直線流路の長さ、流路の断面形状及び流速などが挙げられ、直線流路1aの長さ及び流路の断面形状については、供試流体の粘度と流速を勘案して決定している。

【0016】レーザ光源2は、フローセル1の直線流路1aの所定箇所にレーザ光Laを照射して照射領域を形成する。ここで、レーザ光Laの光軸は、Z方向と一致し、X方向と一致する直線流路1aの中心軸と直交している。

【0017】また、図2に示すように、レーザ光Laの光軸とフローセル1の外壁との成す角を所定角度 θ に設定してもよい。これは、レーザ光Laがフローセル1の外壁に反射して反射光の一部がレーザ光源2に戻るのを防止するためである。反射光の一部がレーザ光源2に戻ると、帰還ノイズがレーザ光Laに重畳するので好ましくないからである。

【0018】なお、レーザ光Laがフローセル1の外壁で反射しないように、例えばレーザ光Laをフローセル1の外壁と同じ物質中を通して直線流路1aの所定箇所に導くことができれば、所定角度 θ を設定する必要はない。

【0019】集光光学系3は、フローセル1の直線流路1aの中心軸と一致する光軸を有し、図2に示す照射領域内の所定の領域M（以下、測定領域Mと呼ぶ）においてレーザ光Laを受けた粒子が発する散乱光Lsを集光する機能を備える。

【0020】光電変換素子アレイ4は、3個の光電変換素子4a、4b、4cから成り、各受光面が流路の中心軸に垂直で、且つ流路の中心軸（X方向）とレーザ光軸（Z方向）に垂直なY方向に隣接して設けられている。光電変換素子4a、4b、4cは、粒子が測定領域Mを通過する間に発する散乱光Lsを電圧に変換する。

【0021】なお、レーザ光Laの光軸とフローセル1の外壁との成す角を、図2に示す所定角度 θ に設定した場合には、光電変換素子4a、4b、4cの受光面を、集光光学系3の光軸に垂直な面に対して所定角度 θ だけ傾けてもよい。

【0022】処理装置5は、粒子が測定領域Mを通過する間に3個の光電変換素子4a、4b、4cが夫々出力する電圧のピーク値（パルス高）Ea、Eb、Ecを検出するピーク値検出手段6a、6b、6cと、粒子情報参照テーブルを作成する粒子情報検出手段7から成る。

【0023】粒子情報検出手段7は、演算部7aと記憶部7bを備え、先ず演算部7aにおいて、次の（1）乃至（3）の演算処理を行い、その結果を記憶部7bに記憶して、粒子情報参照テーブルを作成する。

（1）ピーク値検出手段6bの出力電圧Ebに対するピーク値検出手段6aの出力電圧Eaの比Ea/Ebを演

算する。

(2) ピーク値検出手段6bの出力電圧Ebに対するピーク値検出手段6cの出力電圧Ecの比 E_c/E_b を演算する。

(3) ピーク値検出手段6a, 6b, 6cの出力電圧Ea, Eb, Ecの和($E_a + E_b + E_c$)を演算する。

【0024】以上のように構成した本発明の第1の実施の形態に係る光強度分布検出装置の作用について説明する。図3に示すように、矢印Aの方向から標準粒子(粒径が同一のもの)を多数含んだ流体をフローセル1に流し込む。このとき、測定領域Mのどの位置を標準粒子が通過するかによって、光電変換素子アレイ4の各光電変換素子4a, 4b, 4cの出力波形は様々なものとなる。そして、3個の光電変換素子4a, 4b, 4cから成る光電変換素子アレイ4の場合には、主な5通りの通過パターンが考えられる。

【0025】まず、標準粒子が、図3に示す測定領域Mの中心Mcを通過する場合で、標準粒子による散乱光LsのスポットSは、図4(a)に示すように、光電変換素子アレイ4の中央の光電変換素子4bのみに現れる。このとき、各光電変換素子4a, 4b, 4cの出力波形(時間tと電圧Eとの関係)は、図4(b)に示すようになる。

【0026】即ち、光電変換素子4bのみが測定領域Mの中心Mcをある時間の間(時間t1から時間t2)に通過する標準粒子の散乱光Lsに応じた略パルス状の電圧(ピーク値Eb)を出力し、他の光電変換素子4a, 4cはノイズに応じた略レベル電圧(ピーク値Ea, Ec)しか出力しない。

【0027】次に、標準粒子が、図3に示す測定領域Mの一端部Msを通過する場合で、標準粒子による散乱光LsのスポットSは、図5(a)に示すように、光電変換素子アレイ4の一端の光電変換素子4aのみに現れる。このとき、各光電変換素子4a, 4b, 4cの出力波形(時間tと電圧Eとの関係)は、図5(b)に示すようになる。

【0028】即ち、光電変換素子4aのみが測定領域Mの一端部Msをある時間の間(時間t3から時間t4)に通過する標準粒子の散乱光Lsに応じた略パルス状の電圧(ピーク値Ea)を出力し、他の光電変換素子4b, 4cはノイズに応じた略レベル電圧(ピーク値Eb, Ec)しか出力しない。

【0029】同様に、標準粒子が、図3に示す測定領域Mの他端部Ms(一端部Msと対称)を通過する場合で、標準粒子による散乱光LsのスポットSは、図6(a)に示すように、光電変換素子アレイ4の他端の光電変換素子4cのみに現れる。このとき、各光電変換素子4a, 4b, 4cの出力波形(時間tと電圧Eとの関係)は、図6(b)に示すようになる。

【0030】即ち、光電変換素子4cのみが測定領域M

の他端部Msをある時間の間(時間t3から時間t4)に通過する標準粒子の散乱光Lsに応じた略パルス状の電圧(ピーク値Ec)を出力し、他の光電変換素子4a, 4bはノイズに応じた略レベル電圧(ピーク値Ea, Eb)しか出力しない。

【0031】更に、標準粒子が、図3に示す測定領域Mの一端部Msを通過する場合で、標準粒子による散乱光LsのスポットSは、図7(a)に示すように、光電変換素子4aと光電変換素子4bの境界にまたがって現れる。このとき、各光電変換素子4a, 4b, 4cの出力波形(時間tと電圧Eとの関係)は、図7(b)に示すようになる。

【0032】即ち、光電変換素子4a, 4bが測定領域Mの一端部Msをある時間の間(時間t5から時間t6)に通過する標準粒子の散乱光Lsに応じた略パルス状の電圧(ピーク値Ea, Eb)を出力し、光電変換素子4cはノイズに応じた略レベル電圧(ピーク値Ec)しか出力しない。

【0033】同様に、標準粒子が、図3に示す測定領域Mの他端部Ms(一端部Msと対称)を通過する場合で、標準粒子による散乱光LsのスポットSは、図8(a)に示すように、光電変換素子4bと光電変換素子4cの境界にまたがって現れる。このとき、各光電変換素子4a, 4b, 4cの出力波形(時間tと電圧Eとの関係)は、図8(b)に示すようになる。

【0034】即ち、光電変換素子4b, 4cが測定領域Mの他端部Msをある時間の間(時間t5から時間t6)に通過する標準粒子の散乱光Lsに応じた略パルス状の電圧(ピーク値Eb, Ec)を出力し、光電変換素子4aはノイズに応じた略レベル電圧(ピーク値Ea)しか出力しない。

【0035】そして、粒子情報検出手段7では、図4(a)に示すように、中央の光電変換素子4bのみにスポットSが現れた場合、演算部7aにおいて、光電変換素子4bのピーク電圧Ebに対する光電変換素子4aのピーク電圧Eaの比 E_a/E_b を演算し、 $E_a < E_b$ であるから、比 E_a/E_b としてほぼゼロ($E_a/E_b \approx 0$)の値を出力し、記憶部7bに記憶する。

【0036】また、演算部7aにおいて、光電変換素子4bのピーク電圧Ebに対する光電変換素子4cのピーク電圧Ecの比 E_c/E_b を演算し、 $E_c < E_b$ であるから、比 E_c/E_b としてほぼゼロ($E_c/E_b \approx 0$)の値を出力し、記憶部7bに記憶する。更に、演算部7aにおいて、光電変換素子4a, 4b, 4cの出力電圧Ea, Eb, Ecの和($E_a + E_b + E_c$)を演算し、例えば、1.0を記憶部7bに記憶する。

【0037】また、粒子情報検出手段7では、図5(a)に示すように、一端の光電変換素子4aのみにスポットSが現れた場合、演算部7aにおいて、光電変換素子4bのピーク電圧Ebに対する光電変換素子4aの

ピーク電圧 E_a の比 E_a/E_b を演算し、 $E_a > E_b$ であるから、比 E_a/E_b として非常に大きな値 ($E_a/E_b \rightarrow \infty$) を出力し、記憶部 7 b に記憶する。

【0038】同様に、光電変換素子 4 b のピーク電圧 E_b に対する光電変換素子 4 c のピーク電圧 E_c の比 E_c/E_b を演算し、 $E_c \approx E_b$ であるから、比 E_c/E_b として約 1 ($E_c/E_b \approx 1$) の値を出力し、記憶部 7 b に記憶する。更に、演算部 7 a において、光電変換素子 4 a, 4 b, 4 c の出力電圧 E_a, E_b, E_c の和 ($E_a + E_b + E_c$) を演算し、例えば、0.2 を記憶部 7 b に記憶する。

【0039】また、粒子情報検出手段 7 では、図 6

(a) に示すように、他端の光電変換素子 4 c のみにスポット S が現れた場合、演算部 7 a において、光電変換素子 4 b のピーク電圧 E_b に対する光電変換素子 4 a のピーク電圧 E_a の比 E_a/E_b を演算し、 $E_a \approx E_b$ であるから、比 E_a/E_b として約 1 ($E_a/E_b \approx 1$) の値を出力し、記憶部 7 b に記憶する。

【0040】同様に、光電変換素子 4 b のピーク電圧 E_b に対する光電変換素子 4 c のピーク電圧 E_c の比 E_c/E_b を演算し、 $E_c > E_b$ であるから、比 E_c/E_b として非常に大きな値 ($E_c/E_b \rightarrow \infty$) を出力し、記憶部 7 b に記憶する。更に、演算部 7 a において、光電変換素子 4 a, 4 b, 4 c の出力電圧 E_a, E_b, E_c の和 ($E_a + E_b + E_c$) を演算し、例えば、0.2 を記憶部 7 b に記憶する。

【0041】次に、粒子情報検出手段 7 では、図 7

(a) に示すように、光電変換素子 4 a と光電変換素子 4 b の境界にスポット S がまたがって現れた場合、演算部 7 a において、光電変換素子 4 b のピーク電圧 E_b に対する光電変換素子 4 a のピーク電圧 E_a の比 E_a/E_b を演算し、 $E_a \approx E_b$ であるから、比 E_a/E_b として約 1 ($E_a/E_b \approx 1$) の値を出力し、記憶部 7 b に記憶する。

【0042】同様に、光電変換素子 4 b のピーク電圧 E_b に対する光電変換素子 4 c のピーク電圧 E_c の比 E_c/E_b を演算し、 $E_c < E_b$ であるから、比 E_c/E_b としてほぼゼロ ($E_c/E_b \approx 0$) の値を出力し、記憶部 7 b に記憶する。更に、演算部 7 a において、光電変換素子 4 a, 4 b, 4 c の出力電圧 E_a, E_b, E_c の和 ($E_a + E_b + E_c$) を演算し、例えば、0.75 を記憶部 7 b に記憶する。

【0043】また、粒子情報検出手段 7 では、図 8

(a) に示すように、光電変換素子 4 b と光電変換素子 4 c の境界にスポット S がまたがって現れた場合、演算部 7 a において、光電変換素子 4 b のピーク電圧 E_b に対する光電変換素子 4 a のピーク電圧 E_a の比 E_a/E_b を演算し、 $E_a < E_b$ であるから、比 E_a/E_b としてほぼゼロ ($E_c/E_b \approx 0$) の値を出力し、記憶部 7 b に記憶する。

【0044】同様に、光電変換素子 4 b のピーク電圧 E_b に対する光電変換素子 4 c のピーク電圧 E_c の比 E_c/E_b を演算し、 $E_c \approx E_b$ であるから、比 E_c/E_b として約 1 ($E_c/E_b \approx 1$) の値を出力し、記憶部 7 b に記憶する。更に、演算部 7 a において、光電変換素子 4 a, 4 b, 4 c の出力電圧 E_a, E_b, E_c の和 ($E_a + E_b + E_c$) を演算し、例えば、0.75 を記憶部 7 b に記憶する。

【0045】なお、基準とする電圧は、光電変換素子 4 b のピーク電圧 E_b 以外の他の光電変換素子 4 a, 4 c のピーク電圧 E_a, E_c でもよいし、また各ピーク電圧の和 ($E_a + E_b + E_c$) でもよい。要は、光電変換素子 4 a, 4 b, 4 c のピーク電圧の絶対値ではなく、基準電圧に対する各光電変換素子 4 a, 4 b, 4 c のピーク電圧の比 (割合) から標準粒子による散乱光 L_s のスポット S の位置を求める方が確度が高いからである。

【0046】以上のような 5 通りの場合について、図 9 に示すように、基準電圧を光電変換素子 4 b のピーク電圧 E_b とした場合の粒子情報参照テーブルが作成できる。従って、光電変換素子 4 b のピーク電圧 E_b に対する光電変換素子 4 a のピーク電圧 E_a の比 E_a/E_b と、光電変換素子 4 b のピーク電圧 E_b に対する光電変換素子 4 c のピーク電圧 E_c の比 E_c/E_b が分かれば、それらに対応する出力電圧の和 ($E_a + E_b + E_c$) を得ることにより、レーザ光 L_a が照射されている測定領域 M のレーザ光強度分布を定性的に知ることができる。

【0047】また、上記した 5 通りの通過パターン以外で、光電変換素子 4 a と光電変換素子 4 b の境界又は光電変換素子 4 b と光電変換素子 4 c の境界にスポット S が均等でなくまたがって現れるような測定領域 M の経路を通過した場合であっても、光電変換素子 4 b のピーク電圧 E_b に対する光電変換素子 4 a のピーク電圧 E_a の比 E_a/E_b と、光電変換素子 4 b のピーク電圧 E_b に対する光電変換素子 4 c のピーク電圧 E_c の比 E_c/E_b が分かれば、比 E_a/E_b の値と比 E_c/E_b の値を粒子情報参照テーブルに当てはめることにより、それらに対応する出力電圧の和 ($E_a + E_b + E_c$) を推定し、レーザ光 L_a が照射されている測定領域 M のレーザ光強度分布を定性的に知ることができる。

【0048】本発明の第 2 の実施の形態に係る光強度分布検出装置は、図 10 に示すように、フローセル 11、レーザ光源 12、集光光学系 13、光検出手段 14 及び処理装置 15 から成る。ここで、フローセル 11、レーザ光源 12、集光光学系 13 は、図 1 に示すものと同様の構成であるので説明は省略する。

【0049】光検出手段 14 は、縦 (Y 方向) と横 (Z 方向) が 3 個 \times 3 個のマトリックス状の光電変換素子 $D_{11}, D_{12}, D_{13}, D_{21}, D_{22}, D_{23}, \dots, D_{31}, D_{32}, D_{33}$ から成り、各受光面が流路 11 a の中心軸 (X 方向) に垂直な Y-Z 平面を形

成している。

【0050】処理装置15は、3個×3個の光電変換素子 D_{11} 、 D_{12} 、 D_{13} 、 D_{21} 、 D_{22} 、 D_{23} 、 D_{31} 、 D_{32} 、 D_{33} の夫々の出力電圧のピーク値 E_{11} 、 E_{12} 、 E_{13} 、 E_{21} 、 E_{22} 、 E_{23} 、 E_{31} 、 E_{32} 、 E_{33} を検出するピーク値検出手段16a、16b、16cと、ピーク値 E_{11} 、 E_{12} 、 E_{13} 、 E_{21} 、 E_{22} 、 E_{23} 、 E_{31} 、 E_{32} 、 E_{33} から粒子の位置を検出する粒子情報検出手段17から成る。

【0051】ピーク値検出手段16aは光電変換素子 D_{11} 、 D_{12} 、 D_{13} の出力電圧を時分割でサンプリングしてそのピーク値 E_{11} 、 E_{12} 、 E_{13} を検出し、ピーク値検出手段16bは光電変換素子 D_{21} 、 D_{22} 、 D_{23} の出力電圧を時分割でサンプリングしてそのピーク値 E_{21} 、 E_{22} 、 E_{23} を検出し、ピーク値検出手段16cは光電変換素子 D_{31} 、 D_{32} 、 D_{33} の出力電圧を時分割でサンプリングしてピーク値 E_{31} 、 E_{32} 、 E_{33} を検出する。

【0052】なお、ピーク値検出手段を光電変換素子の個数分設け、測定領域Mをある時間で通過する粒子の散乱光 L_s による出力電圧を常時サンプリングしてピーク値を検出してよい。

【0053】粒子情報検出手段17は、演算部17aと記憶部17bを備え、先ず演算部17aにおいて、ピーク値検出手段16a、16b、16cが検出したピーク値 E_{11} 、 E_{12} 、 E_{13} 、 E_{21} 、 E_{22} 、 E_{23} 、 E_{31} 、 E_{32} 、 E_{33} の中から一の電圧（例えば、ピーク値 E_{11} ）を選択し、この電圧を基準にして他のピーク値との比（ E_{11}/E_{12} 、 E_{11}/E_{13} 、 E_{11}/E_{21} 、 E_{11}/E_{22} 、 E_{11}/E_{23} 、 E_{11}/E_{31} 、 E_{11}/E_{32} 、 E_{11}/E_{33} ）を演算し、その結果を記憶部17bに記憶する。更に、演算部17aにおいて、ピーク値 E_{11} 、 E_{12} 、 E_{13} 、 E_{21} 、 E_{22} 、 E_{23} 、 E_{31} 、 E_{32} 、 E_{33} の和（ $E_{11}+E_{12}+E_{13}+E_{21}+E_{22}+E_{23}+E_{31}+E_{32}+E_{33}$ ）を演算し、例えば、1.0を記憶部17bに記憶する。

【0054】そして、粒子情報検出手段17において、スポットSが、9個の光電変換素子 D_{11} 、 D_{12} 、 D_{13} 、 D_{21} 、 D_{22} 、 D_{23} 、 D_{31} 、 D_{32} 、 D_{33} のうち互いに隣接する部位、例えば光電変換素子 D_{11} と光電変換素子 D_{12} の接する部位や、9個の光電変換素子 D_{11} 、 D_{12} 、 D_{13} 、 D_{21} 、 D_{22} 、 D_{23} 、 D_{31} 、 D_{32} 、 D_{33} のうち4個の光電変換素子のコーナ部が接する部位、例えば4個の光電変換素子 D_{11} 、 D_{12} 、 D_{21} 、 D_{22} のコーナ部が接する部位に現れるような測定領域Mの経路を通過した場合も考慮して、図9と同様な粒子情報参照テーブルを作成する。

【0055】また、演算部17aにおいて、ピーク値検出手段16a、16b、16cが検出したピーク値 E_{11} 、 E_{12} 、 E_{13} 、 E_{21} 、 E_{22} 、 E_{23} 、 E_{31} 、 E_{32} 、 E_{33} の中から最も大きいピーク値を選択し、その結果を記憶部17bに記憶してもよい。

【0056】以上のように構成した本発明の第2の実施の形態に係る光強度分布検出装置の作用について説明する。図10に示すように、矢印Aの方向から標準粒子（粒径が同一のもの）を多数含んだ流体をフローセル1に流し込む。このとき、測定領域Mのどの位置を粒子

が通過するかによって、光検出手段14の光電変換素子 D_{11} 、 D_{12} 、 D_{13} 、 D_{21} 、 D_{22} 、 D_{23} 、 D_{31} 、 D_{32} 、 D_{33} の出力波形は様々なものとなる。

【0057】例えば、粒子が光検出手段14の中で光電変換素子 D_{11} の受光面に対応する測定領域Mの経路を通過すると、ピーク値検出手段16a、16b、16cは粒子が測定領域Mを通過する間、粒子の散乱光 L_s に応じた光電変換素子 D_{11} 、 D_{12} 、 D_{13} 、 D_{21} 、 D_{22} 、 D_{23} 、 D_{31} 、 D_{32} 、 D_{33} の出力電圧をサンプリングしてピーク値を検出する。

【0058】この場合に、測定領域Mのレーザ光強度は、中心部が最も強く、中心部からずれて端部に行くほど弱くなるという分布（ほぼガウス分布）をしているので、粒子はレーザ光強度の弱い部分から中心部の強い部分を通り再び弱い部分を通るため、光電変換素子 D_{11} のみが略パルス状の電圧を出力し、他の光電変換素子は、ノイズに応じたレベル電圧しか出力しない。

【0059】従って、光電変換素子 D_{11} のピーク値 E_{11} を基準にした場合に、他のピーク値との比（ E_{11}/E_{12} 、 E_{11}/E_{13} 、 E_{11}/E_{21} 、 E_{11}/E_{22} 、 E_{11}/E_{23} 、 E_{11}/E_{31} 、 E_{11}/E_{32} 、 E_{11}/E_{33} ）が分かれば、粒子情報参照テーブルを参照することにより、レーザ光 L_a が照射されている測定領域Mのレーザ光強度分布を定性的に知ることができる。

【0060】本発明の第3の実施の形態に係る光強度分布検出装置は、図11に示すように、フローセル21、レーザ光源22、集光光学系23、トラップ20、光電変換素子アレイ24及び処理装置25から成る。

【0061】フローセル21は、透明部材から成り、所定長さの直線流路21a（Y方向）を有する。ここでは、フローセル21の断面形状は角筒形状としている。所定の長さの直線流路21aを設けた理由は、請求項2に係る光強度分布検出装置のフローセル1の場合と同様である。

【0062】レーザ光源22は、フローセル21の直線流路21aの所定の箇所にレーザ光 L_a を照射して照射領域を形成する。ここで、レーザ光 L_a の光軸（X方向）と直線流路21a（Y方向）は交差している。

【0063】集光光学系23は、レーザ光源22の光軸と一致する光軸（X方向）を有し、図12に示す照射領域内の所定の領域M（以下、測定領域Mと呼ぶ）において発生する散乱光 L_s を集光する機能を備える。

【0064】光電変換素子アレイ24は、3個の光電変換素子24a、24b、24cから成り、各受光面が集光光学系23の光軸（X方向）に垂直で、且つ流路の中心軸（Y方向）とレーザ光軸（X方向）に垂直なZ方向に隣接して設けられている。光電変換素子24a、24b、24cは、粒子が測定領域Mを通過する間に発する散乱光 L_s を電圧に変換する。

【0065】集光光学系23の光軸上に位置するトラップ20は、レーザ光源22の光源光 L_a が直接、光電変換素子アレイ24に入射するのを阻止する。これによ

り、光電変換素子24には、流路21a内を通過する粒子が発する散乱光Lsのみが入射することになる。

【0066】処理装置25は、粒子が測定領域Mを通過する間に3個の光電変換素子24a、24b、24cが夫々出力する電圧のピーク値(パルス高)Ea、Eb、Ecを検出するピーク値検出手段26a、26b、26cと、粒子情報参照テーブルを作成する粒子情報検出手段27から成る。

【0067】粒子情報検出手段27は、演算部27aと記憶部27bを備え、先ず演算部27aにおいて、次の(1)乃至(3)の演算処理を行い、その結果を記憶部27bに記憶して、粒子情報参照テーブルを作成する。

(1)ピーク値検出手段26bの出力電圧Ebに対するピーク値検出手段26aの出力電圧Eaの比 Ea/Eb を演算する。

(2)ピーク値検出手段26bの出力電圧Ebに対するピーク値検出手段26cの出力電圧Ecの比 Ec/Eb を演算する。

(3)ピーク値検出手段26a、26b、26cの出力電圧Ea、Eb、Ecの和($Ea+Eb+Ec$)を演算する。

【0068】以上のように構成した本発明の第3の実施の形態に係る光強度分布検出装置の作用について説明する。図12に示すように、矢印Aの方向から標準粒子(粒径が同一のもの)を多数含んだ流体をフローセル21に流し込む。このとき、測定領域Mのどの位置を粒子が通過するかによって、光電変換素子アレイ24の各光電変換素子24a、24b、24c出力波形は様々なものとなる。そして、3個の光電変換素子24a、24b、24cから成る光電変換素子アレイ24の場合には、主な5通りの通過パターンが考えられる。

【0069】先ず、標準粒子が、図12に示す測定領域Mの中心Mcを通過する場合で、標準粒子による散乱光LsのスポットSは、図13(a)に示すように、光電変換素子アレイ24の中央の光電変換素子24bのみに現れ、矢印方向に移動する。このとき、各光電変換素子24a、24b、24cの出力波形(時間tと電圧Eとの関係)は、図13(b)に示すようになる。

【0070】即ち、光電変換素子24bのみが測定領域Mの中心Mcをある時間の間(時間t1から時間t2)に通過する標準粒子の散乱光Lsに応じた略パルス状の電圧(ピーク値Eb)を出力し、他の光電変換素子24a、24cはノイズに応じた略レベル電圧(ピーク値Ea、Ec)しか出力しない。

【0071】次に、標準粒子が、図12に示す測定領域Mの一端部Msを通過する場合で、標準粒子による散乱光LsのスポットSは、図14(a)に示すように、光電変換素子アレイ24の一端の光電変換素子24aのみに現れ、矢印方向に移動する。このとき、各光電変換素子24a、24b、24cの出力波形(時間tと電圧E

との関係)は、図14(b)に示すようになる。

【0072】即ち、光電変換素子24aのみが測定領域Mの一端部Msをある時間の間(時間t3から時間t4)に通過する標準粒子の散乱光Lsに応じた略パルス状の電圧(ピーク値Ea)を出力し、他の光電変換素子24b、24cはノイズに応じた略レベル電圧(ピーク値Eb、Ec)しか出力しない。

【0073】同様に、標準粒子が、図12に示す測定領域Mの他端部Ms(一端部Msと対称の位置)を通過する場合で、標準粒子による散乱光LsのスポットSは、図15(a)に示すように、光電変換素子アレイ24の他端の光電変換素子24cのみに現れ、矢印方向に移動する。このとき、各光電変換素子24a、24b、24cの出力波形(時間tと電圧Eとの関係)は、図15(b)に示すようになる。

【0074】即ち、光電変換素子24cのみが測定領域Mの他端部Msをある時間の間(時間t3から時間t4)に通過する標準粒子の散乱光Lsに応じた略パルス状の電圧(ピーク値Ec)を出力し、他の光電変換素子24a、24bはノイズに応じた略レベル電圧(ピーク値Ea、Eb)しか出力しない。

【0075】更に、標準粒子が、図12に示す測定領域Mの一经路Mmを通過する場合で、標準粒子による散乱光LsのスポットSは、図16(a)に示すように、光電変換素子24aと光電変換素子24bの境界にまたがって現れ、矢印方向に移動する。このとき、各光電変換素子24a、24b、24cの出力波形(時間tと電圧Eとの関係)は、図16(b)に示すようになる。

【0076】即ち、光電変換素子24a、24bが測定領域Mの一经路Mmをある時間の間(時間t5から時間t6)に通過する標準粒子の散乱光Lsに応じた略パルス状の電圧(ピーク値Ea、Eb)を出力し、光電変換素子24cはノイズに応じた略レベル電圧(ピーク値Ec)しか出力しない。

【0077】同様に、標準粒子が、図12に示す測定領域Mの他経路Mm(一经路Mmと対称の位置)を通過する場合で、標準粒子による散乱光LsのスポットSは、図17(a)に示すように、光電変換素子24bと光電変換素子24cの境界にまたがって現れ、矢印方向に移動する。このとき、各光電変換素子24a、24b、24cの出力波形(時間tと電圧Eとの関係)は、図17(b)に示すようになる。

【0078】即ち、光電変換素子24b、24cが測定領域Mの他経路Mmをある時間の間(時間t5から時間t6)に通過する標準粒子の散乱光Lsに応じた略パルス状の電圧(ピーク値Eb、Ec)を出力し、光電変換素子24aはノイズに応じた略レベル電圧(ピーク値Ea)しか出力しない。

【0079】そして、粒子情報検出手段27では、図13(a)に示すように、中央の光電変換素子24bのみ

にスポットSが現れた場合、演算部17aにおいて、光電変換素子24bのピーク電圧Ebに対する光電変換素子24aのピーク電圧Eaの比 Ea/Eb を演算し、 $Ea < Eb$ であるから、比 Ea/Eb としてほぼゼロ ($Ea/Eb \approx 0$) の値を出力し、記憶部27bに記憶する。

【0080】また、演算部27aにおいて、光電変換素子24bのピーク電圧Ebに対する光電変換素子24cのピーク電圧Ecの比 Ec/Eb を演算し、 $Ec < Eb$ であるから、比 Ec/Eb としてほぼゼロ ($Ec/Eb \approx 0$) の値を出力し、記憶部27bに記憶する。更に、演算部27aにおいて、光電変換素子24a、24b、24cの出力電圧Ea、Eb、Ecの和 ($Ea + Eb + Ec$) を演算し、例えば、1.0を記憶部27bに記憶する。

【0081】また、粒子情報検出手段27では、図14(a)に示すように、一端の光電変換素子24aのみにスポットSが現れた場合、演算部27aにおいて、光電変換素子24bのピーク電圧Ebに対する光電変換素子24aのピーク電圧Eaの比 Ea/Eb を演算し、 $Ea > Eb$ であるから、比 Ea/Eb として非常に大きい値 ($Ea/Eb \approx \infty$) を出力し、記憶部27bに記憶する。

【0082】同様に、光電変換素子24bのピーク電圧Ebに対する光電変換素子24cのピーク電圧Ecの比 Ec/Eb を演算し、 $Ec \approx Eb$ であるから、比 Ea/Eb として約1 ($Ea/Eb \approx 1$) の値を出力し、記憶部27bに記憶する。更に、演算部27aにおいて、光電変換素子24a、24b、24cの出力電圧Ea、Eb、Ecの和 ($Ea + Eb + Ec$) を演算し、例えば、0.2を記憶部27bに記憶する。

【0083】また、粒子情報検出手段27では、図15(a)に示すように、他端の光電変換素子24cのみにスポットSが現れた場合、演算部27aにおいて、光電変換素子24bのピーク電圧Ebに対する光電変換素子24aのピーク電圧Eaの比 Ea/Eb を演算し、 $Ea \approx Eb$ であるから、比 Ea/Eb として約1 ($Ea/Eb \approx 1$) の値を出力し、記憶部27bに記憶する。

【0084】同様に、光電変換素子24bのピーク電圧Ebに対する光電変換素子24cのピーク電圧Ecの比 Ec/Eb を演算し、 $Ec > Eb$ であるから、比 Ec/Eb として非常に大きい値 ($Ec/Eb \approx \infty$) を出力し、記憶部27bに記憶する。更に、演算部27aにおいて、光電変換素子24a、24b、24cの出力電圧Ea、Eb、Ecの和 ($Ea + Eb + Ec$) を演算し、例えば、0.2を記憶部27bに記憶する。

【0085】次に、粒子情報検出手段27では、図16(a)に示すように、光電変換素子24aと光電変換素子24bの境界にスポットSがまたがって現れた場合、演算部27aにおいて、光電変換素子24bのピーク電

圧Ebに対する光電変換素子24aのピーク電圧Eaの比 Ea/Eb を演算し、 $Ea \approx Eb$ であるから、比 Ea/Eb として約1 ($Ea/Eb \approx 1$) の値を出力し、記憶部27bに記憶する。

【0086】同様に、光電変換素子24bのピーク電圧Ebに対する光電変換素子24cのピーク電圧Ecの比 Ec/Eb を演算し、 $Ec < Eb$ であるから、比 Ec/Eb としてほぼゼロ ($Ec/Eb \approx 0$) の値を出力し、記憶部27bに記憶する。更に、演算部27aにおいて、光電変換素子24a、24b、24cの出力電圧Ea、Eb、Ecの和 ($Ea + Eb + Ec$) を演算し、例えば、0.75を記憶部27bに記憶する。

【0087】また、粒子情報検出手段27では、図17(a)に示すように、光電変換素子24bと光電変換素子24cの境界にスポットSがまたがって現れた場合、演算部27aにおいて、光電変換素子24bのピーク電圧Ebに対する光電変換素子24aのピーク電圧Eaの比 Ea/Eb を演算し、 $Ea < Eb$ であるから、比 Ea/Eb としてほぼゼロ ($Ec/Eb \approx 0$) の値を出力し、記憶部27bに記憶する。

【0088】同様に、光電変換素子24bのピーク電圧Ebに対する光電変換素子24cのピーク電圧Ecの比 Ec/Eb を演算し、 $Ec \approx Eb$ であるから、比 Ec/Eb として約1 ($Ec/Eb \approx 1$) の値を出力し、記憶部27bに記憶する。更に、演算部27aにおいて、光電変換素子24a、24b、24cの出力電圧Ea、Eb、Ecの和 ($Ea + Eb + Ec$) を演算し、例えば、0.75を記憶部27bに記憶する。

【0089】なお、基準とする電圧は、光電変換素子24bのピーク電圧Eb以外の他の光電変換素子24a、24cのピーク電圧Ea、Ecでもよいし、また各ピーク電圧の和 ($Ea + Eb + Ec$) でもよい。要は、光電変換素子24a、24b、24cのピーク電圧の絶対値ではなく、基準電圧に対する各光電変換素子24a、24b、24cのピーク電圧の比(割合)から標準粒子による散乱光LsのスポットSの位置を求める方が精度が高いからである。

【0090】以上のような5通りの場合について、図9に示す粒子情報参照テーブルと同様な、基準電圧を光電変換素子24bのピーク電圧Ebとした場合の粒子情報参照テーブルが作成できる。従って、光電変換素子24bのピーク電圧Ebに対する光電変換素子24aのピーク電圧Eaの比 Ea/Eb と、光電変換素子24bのピーク電圧Ebに対する光電変換素子24cのピーク電圧Ecの比 Ec/Eb が分かれば、それらに対応する出力電圧の和 ($Ea + Eb + Ec$) を得ることにより、レーザ光Laが照射されている測定領域Mのレーザ光強度分布を定性的に知ることができる。

【0091】また、上記した5通りの通過パターン以外で、光電変換素子24aと光電変換素子24bの境界又

は光電変換素子 2 4 b と光電変換素子 2 4 c の境界にスポット S がまたがって現れるような測定領域 M の経路を通過した場合であっても、光電変換素子 2 4 b のピーク電圧 E b に対する光電変換素子 2 4 a のピーク電圧 E a の比 $E a / E b$ と、光電変換素子 2 4 b のピーク電圧 E b に対する光電変換素子 2 4 c のピーク電圧 E c の比 $E c / E b$ が分かれば、比 $E a / E b$ の値と比 $E c / E b$ の値を粒子情報参照テーブルに当てはめることにより、それらに対応する出力電圧の和 ($E a + E b + E c$) を推定し、レーザ光 L a が照射されている測定領域 M のレーザ光強度分布を定性的に知ることができる。

【0092】本発明は、上述の発明の実施の形態に限定されるものではなく、例えば、フローセルの全体形状としては、L 型のフローセル 1、1 1 や直線状のフローセル 2 1 を用いたが、要は流路の中心軸と集光光学系の光軸が一致するように配置できる形状であればよい。従って、レーザ光 L a と散乱光 L s との光学的な関わりに影響を与えなければ、フローセルの全体形状は、屈曲又は湾曲形状であってもよい。

【0093】また、フローセルの断面形状として、上述の発明の実施の形態では、矩形のものをを用いたが、円形のものでもよい。

【0094】

【発明の効果】以上説明したように請求項 1 に係る発明によれば、光を照射した測定領域を通過する粒子の散乱光強度分布とその粒子が通過した流路の位置から、測定領域の光強度分布を知ることができる。

【0095】請求項 2 に係る発明によれば、光を照射した測定領域を通過する粒子の散乱光強度分布とその粒子が通過した流路の位置から、測定領域の光強度分布を知ることができる。

【0096】請求項 3 に係る発明によれば、光を照射した測定領域を通過する粒子の散乱光強度分布とその粒子が通過した流路の位置から、測定領域の光強度分布をより細かく知ることができる。

【0097】請求項 4 に係る発明によれば、光を照射した測定領域を通過する粒子の散乱光強度分布とその粒子が通過した流路の位置から、測定領域の光強度分布を知ることができる。

【0098】請求項 5 に係る発明によれば、光を照射した測定領域を通過する粒子の散乱光強度分布とその粒子が通過した流路の位置から、測定領域の光強度分布を知ることができる。

【図面の簡単な説明】

【図 1】本発明の第 1 の実施の形態に係る光強度分布検

出装置の構成図

【図 2】図 1 におけるレーザ光を照射した測定領域の平面断面図

【図 3】図 1 におけるレーザ光を照射した測定領域の縦断面図

【図 4】図 1 における光電変換素子アレイの受光状態 (a) とそのときの出力波形 (b) を示す図

【図 5】図 1 における光電変換素子アレイの受光状態 (a) とそのときの出力波形 (b) を示す図

【図 6】図 1 における光電変換素子アレイの受光状態 (a) とそのときの出力波形 (b) を示す図

【図 7】図 1 における光電変換素子アレイの受光状態 (a) とそのときの出力波形 (b) を示す図

【図 8】図 1 における光電変換素子アレイの受光状態 (a) とそのときの出力波形 (b) を示す図

【図 9】粒子情報参照テーブル示す図

【図 10】本発明の第 2 の実施の形態に係る光強度分布検出装置の構成図

【図 11】本発明の第 3 の実施の形態に係る光強度分布検出装置の構成図

【図 12】図 11 におけるレーザ光を照射した測定領域の縦断面図

【図 13】図 11 における光電変換素子アレイの受光状態 (a) とそのときの出力波形 (b) を示す図

【図 14】図 11 における光電変換素子アレイの受光状態 (a) とそのときの出力波形 (b) を示す図

【図 15】図 11 における光電変換素子アレイの受光状態 (a) とそのときの出力波形 (b) を示す図

【図 16】図 11 における光電変換素子アレイの受光状態 (a) とそのときの出力波形 (b) を示す図

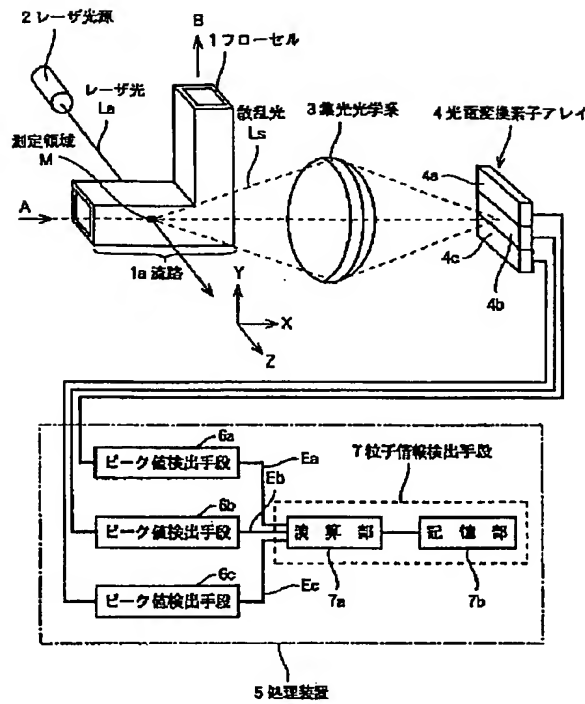
【図 17】図 11 における光電変換素子アレイの受光状態 (a) とそのときの出力波形 (b) を示す図

【図 18】従来の光散乱式粒子計数装置の構成図

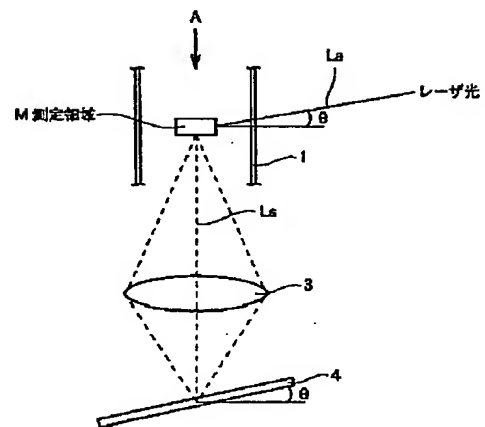
【符号の説明】

1、1 1、2 1…フローセル、1 a、1 1 a、2 1 a…直線流路、2、1 2、2 2…レーザ光源 (光源)、3、1 3、2 3…集光光学系 (集光手段)、4、2 4…光電変換素子アレイ、4 a、4 b、4 c、2 4 a、2 4 b、2 4 c…光電変換素子、5、1 5、2 5…処理装置、6 a、6 b、6 c、1 6 a、1 6 b、1 6 c、2 6 a、2 6 b、2 6 c…ピーク値検出手段 (電圧検出手段)、7、1 7、2 7…粒子情報検出手段、1 4…光検出手段、2 0…トラップ、L a…レーザ光、L s…散乱光、M…測定領域。

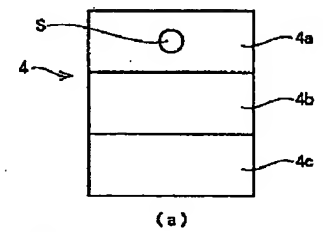
【図 1】



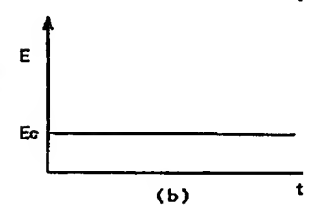
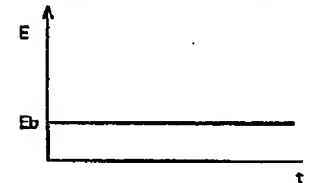
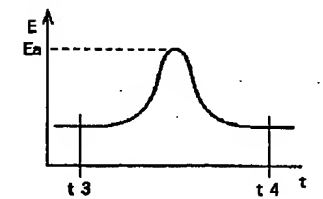
【図 2】



【図 5】

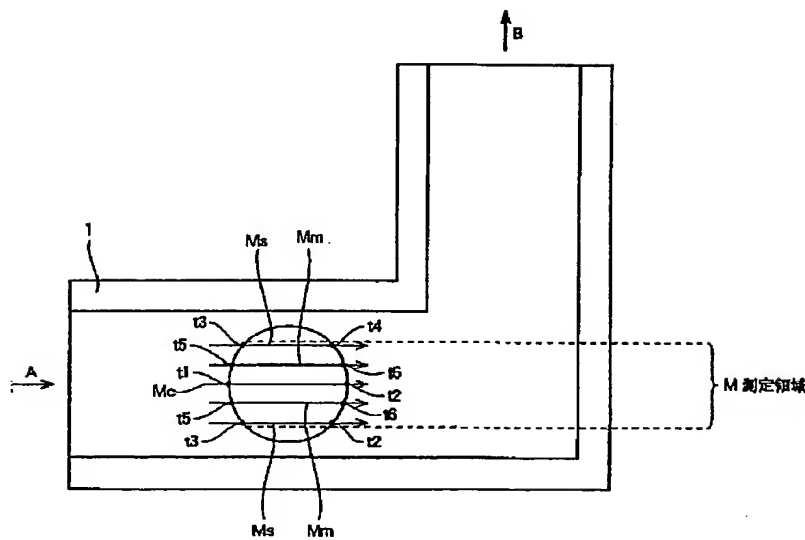


(a)

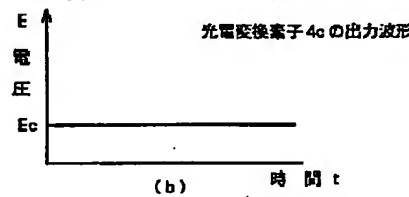
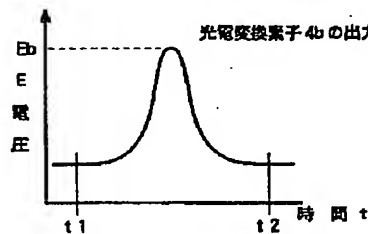
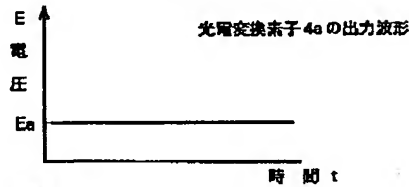
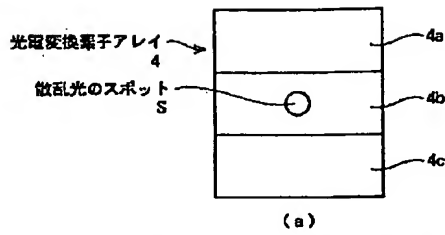


(b)

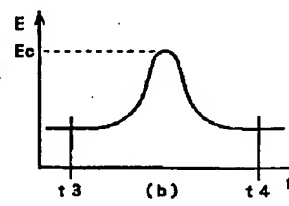
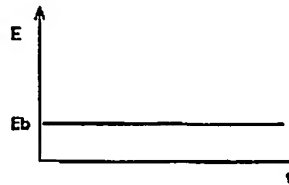
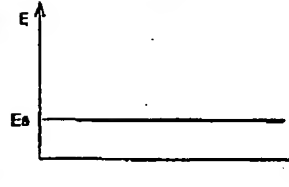
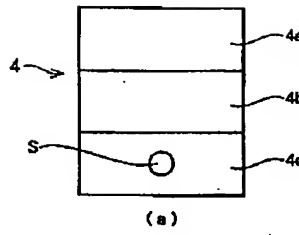
【図 3】



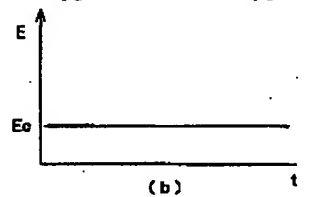
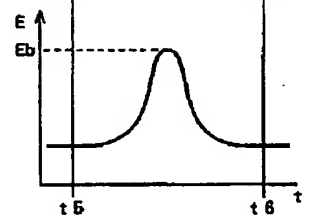
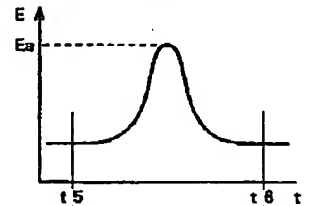
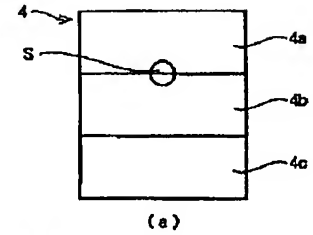
【 図 4 】



【 図 6 】



【 図 7 】

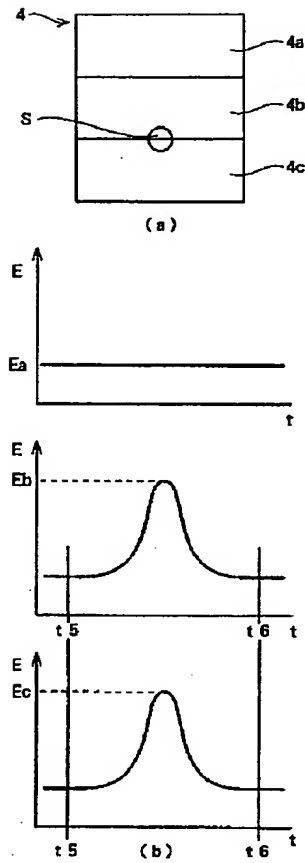


【 図 9 】

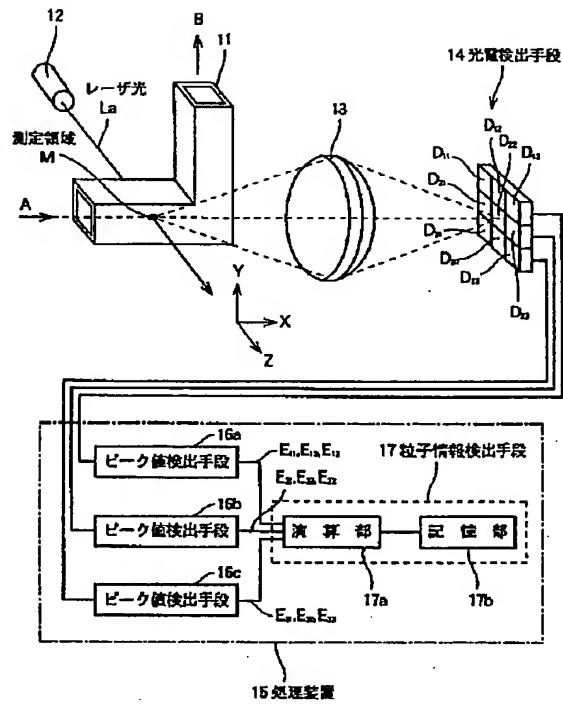
粒子情報参照テーブル

	光電変換素子 4b の出力に対する 光電変換素子 4a の出力の比 (E_a/E_b)	光電変換素子 4b の出力に対する 光電変換素子 4c の出力の比 (E_c/E_b)	光電変換素子 4a, 4b, 4c の出力の和 ($E_a + E_b + E_c$)
光電変換素子 4a のみに スポットが現れた場合	∞	≈ 1	0.2
光電変換素子 4a, 4b の 境界にまたがって スポットが現れた場合	≈ 1	≈ 0	0.75
光電変換素子 4b のみに スポットが現れた場合	≈ 0	≈ 0	1.0
光電変換素子 4b, 4c の 境界にまたがって スポットが現れた場合	≈ 0	≈ 1	0.75
光電変換素子 4c のみに スポットが現れた場合	≈ 1	∞	0.2

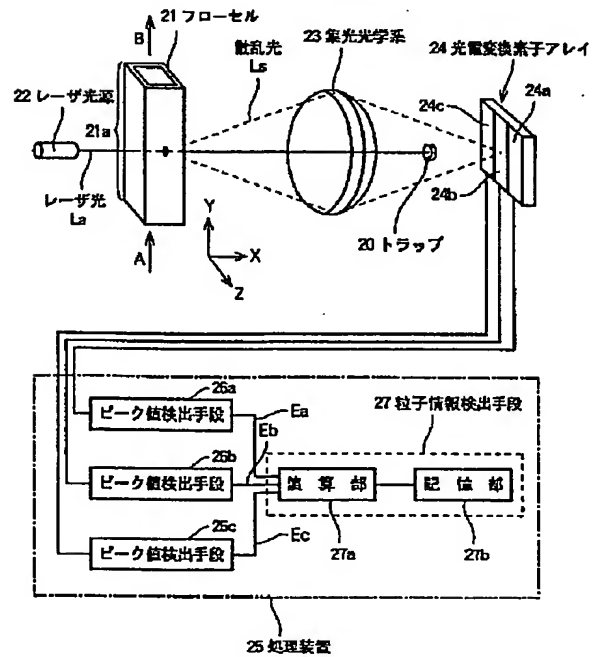
【図 8】



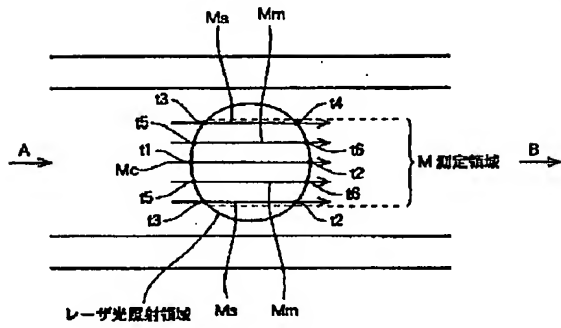
【図 10】



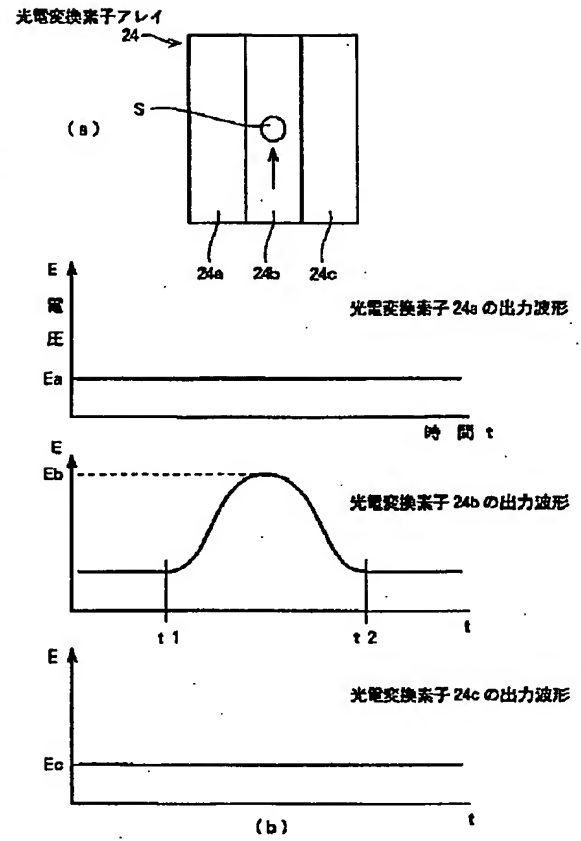
【図 11】



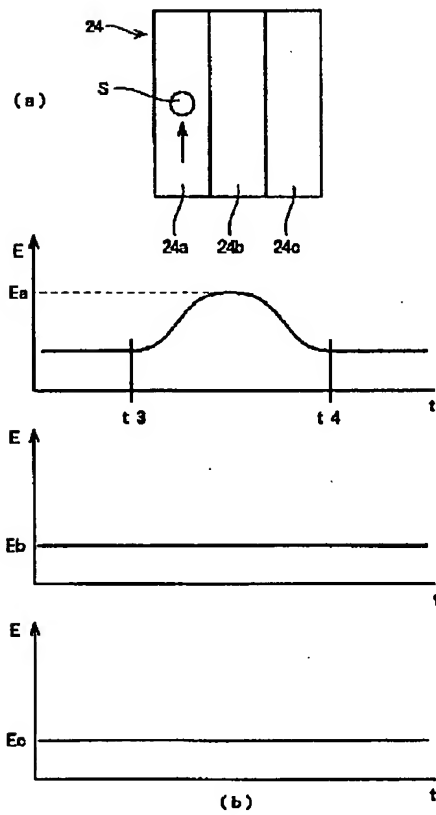
【図 12】



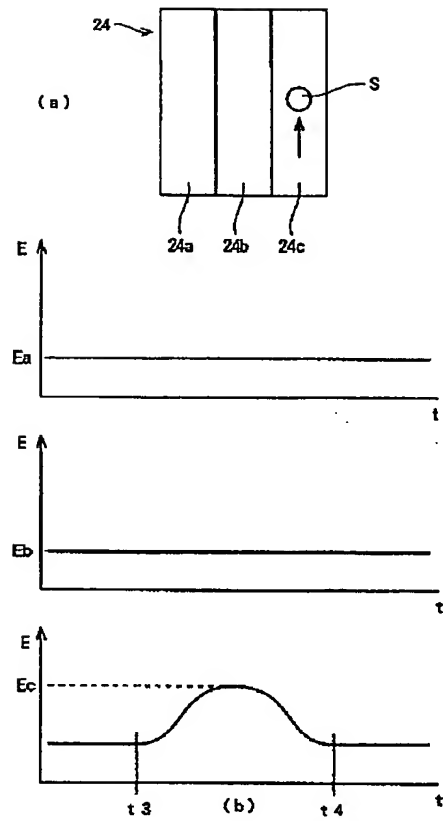
【図 13】



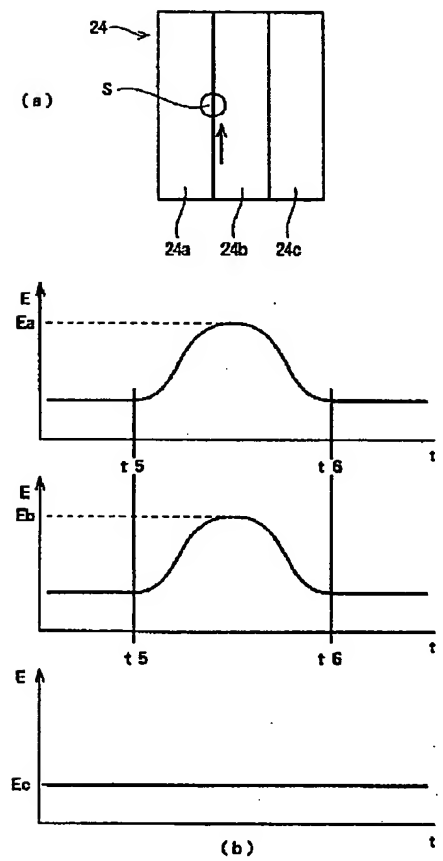
【図 14】



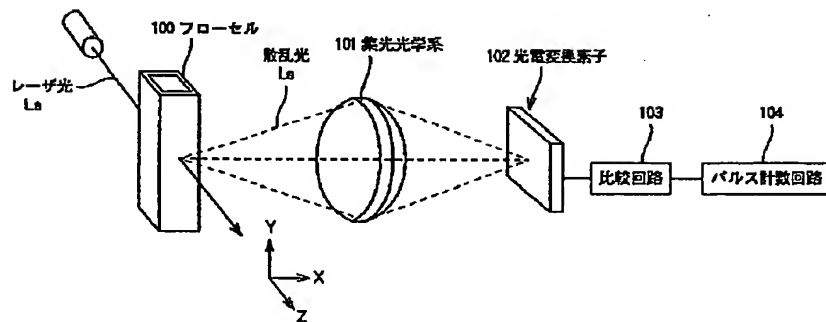
【図 15】



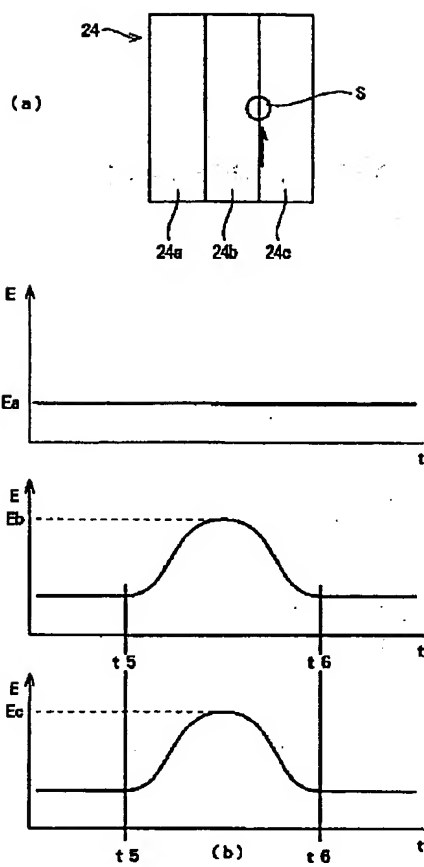
【図 16】



【図 18】



【 図 1 7 】



THIS PAGE BLANK (USPTO)